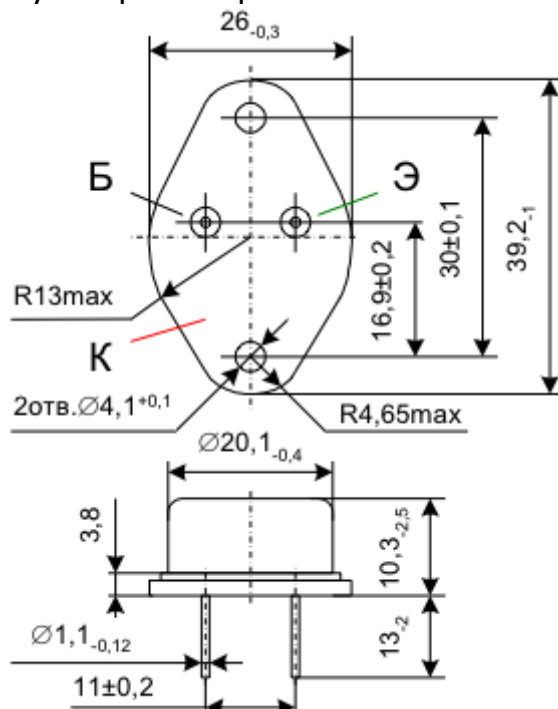


КТ808БМ

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры n-p-n переключаемые. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения.



Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

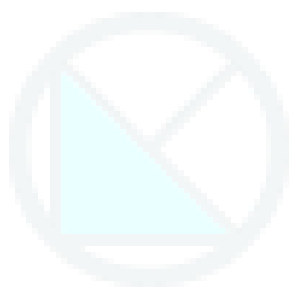
Тип корпуса: КТ-9. Масса транзистора не более 20 г.

Технические условия: аА0.336.240 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ808БМ:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ при $U_{кэ}=3$ В, $I_{к}=2$ А: 20...125;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока для схем с ОЭ: не менее 8 МГц;
- $U_{кэ\text{ нас}}$ – Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{к}=6$ А, $I_{б}=0,6$ А: не более 1,5 В;
- $U_{бэ\text{ нас}}$ – Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{к}=6$ А, $I_{б}=0,6$ А: не более 2,5 В;
- $t_{рас}$ - Время рассасывания при $U_{кэ}=15$ В, $I_{к}=6$ А: не более 2 мкс;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кэ}=U_{кэг\text{ max}}$, $t_{к}=+25^{\circ}\text{C}$: не более 2 мА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 500 пФ;
- $U_{кэг\text{ max}}$ - Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ}=10$ Ом, $t_{п}\leq 100^{\circ}\text{C}$: 100 В;

- $U_{кэ и тах}$ – Максимальное импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ}=10 \text{ Ом}$, $Q \geq 7$: 160 В;
- $U_{эб0 тах}$ – Максимальное постоянное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_{к тах}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 10 А;
- $I_{к и тах}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 15 А;
- $P_{к т тах}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $t_{к} \leq +50^{\circ}\text{C}$: не более 70 Вт.
- $t_{п}$ – Температура р-п перехода: не более + 150°C;
- $t_{окр}$ – Температура окружающей среды: -60... $t_{к}=+125^{\circ}\text{C}$.



РАДИОЭЛЕМЕНТ